



2N5551 (3DG5551)

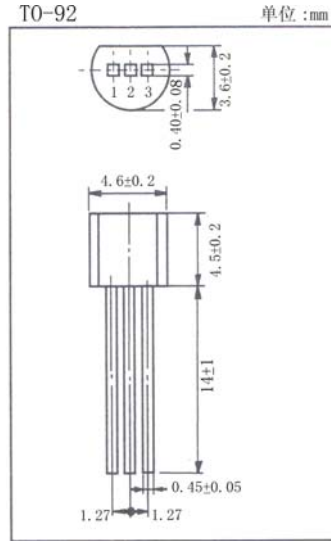
硅 NPN 半导体三极管/SILICON NPN TRANSISTOR

用途:用于普通高压放大。/Purpose: General purpose high voltage amplifier.

特点:击穿电压高,可与 2N5401(3CG5401)互补。/Features: High voltage, complementary Pair with 2N5401(3CG5401).

极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25°C)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
$V_{CB0}$	180	V
$V_{CEO}$	160	V
$V_{EBO}$	6.0	V
$I_C$	600	mA
$I_B$	300	mA
$P_C$	625	mW
$T_j$	150	°C
$T_{stg}$	-55~150	°C



引脚: 1. E 2. B 3. C

电性能参数/Electrical characteristics(Ta=25°C)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
$I_{CB0}$	$V_{CB}=180V$ $I_E=0$			0.1	$\mu A$
$I_{EBO}$	$V_{EB}=6.0V$ $I_C=0$			0.1	$\mu A$
$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=10mA$	50	200	400	
$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=50mA$	20	160		
$h_{FE(3)}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=1.0mA$	40	190		
$V_{CE(sat)1}$	$I_C=10mA$ $I_B=1.0mA$		0.06	0.15	V
$V_{CE(sat)2}$	$I_C=50mA$ $I_B=5.0mA$		0.09	0.3	V
$V_{BE(sat)1}$	$I_C=10mA$ $I_B=1.0mA$		0.7	1.0	V
$V_{BE(sat)2}$	$I_C=50mA$ $I_B=5.0mA$		0.8	1.0	V
$V_{BE}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=10mA$		0.68	0.75	V
$f_T$	$V_{CE}=10V$ $I_C=10mA$	50	110		MHz
$C_{ob}$	$V_{CB}=10V$ $I_E=0$ $f=1.0MHz$		2.2	5.0	pF
$t_{on}$	$I_C=100mA$ $I_{B1}=-I_{B2}=10mA$		0.3		$\mu s$
$t_{off}$	$I_C=100mA$ $I_{B1}=-I_{B2}=10mA$		0.4		$\mu s$
$t_{stg}$	$I_C=100mA$ $I_{B1}=-I_{B2}=10mA$		0.2		$\mu s$

$h_{FE(1)}$  分档/ $h_{FE(1)}$  classifications: A:50~150 B:100~300 C:200~400

